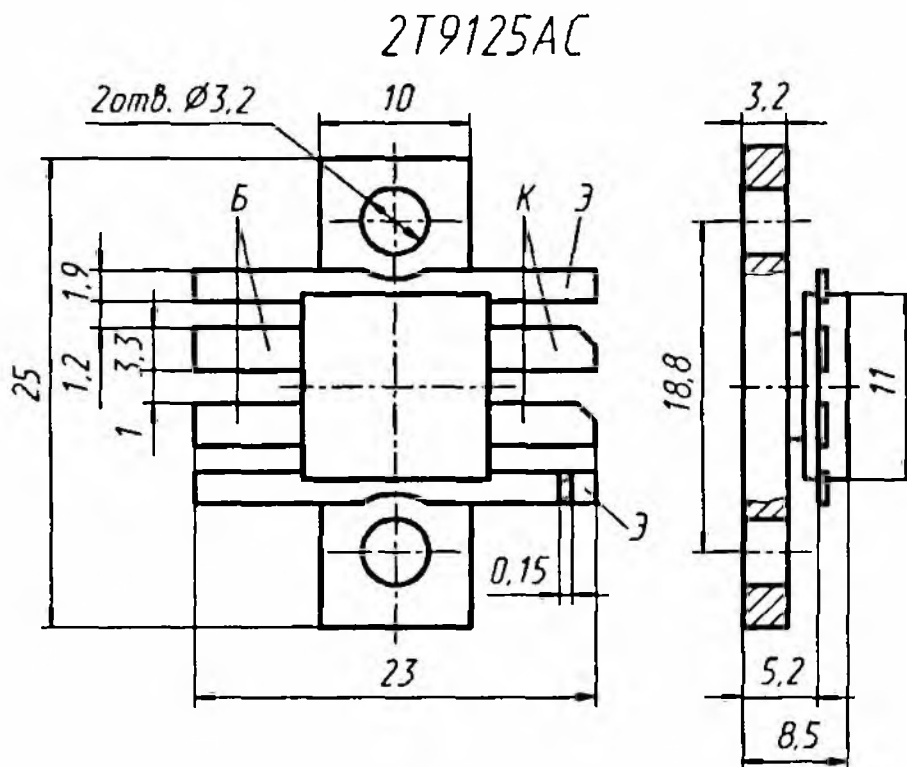


2Т9125АС

Сборка из двух кремниевых эпитаксиально-планарных структуры *n-p-n* генераторных транзисторов. Предназначена для применения в двухтактных широкополосных усилителях мощности и генераторах в диапазоне частот 100...500 МГц в схеме ОЭ при напряжении питания 28 В. Выпускается в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип сборки указывается на корпусе.

Масса сборки не более 10 г.



Электрические параметры

Выходная мощность в двухтактной схеме на частоте $f = 500$ МГц при $U_{п} = 28$ В, $P_{вх} = 12,5$ Вт, $T_{к} \leq +40$ °С, не менее	50 Вт
Коэффициент усиления по мощности в двухтактной схеме на частоте $f = 500$ МГц при $U_{п} = 28$ В, $P_{вх} = 50$ Вт, $T_{к} \leq +40$ °С	4...7,2*...9,8*
Коэффициент полезного действия в двухтактной схеме на частоте $f = 500$ МГц при $U_{п} = 28$ В, $P_{вх} = 50$ Вт, $T_{к} \leq +40$ °С	50...55,2*...70*%
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 5$ В, $I_{к} = 0,5$ А, не более..	110

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кэ} = 5$ В, $I_k = 3$ А, $f = 300$ МГц	2,2...3*...4,9*
Граничное напряжение при $I_3 = 50$ мА, не менее	30* В
Критический ток при $U_{кэ} = 10$ В на $f = 300$ МГц	6*...9,6*... 13* А
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{кб} = 5$ В, $I_3 = 0,5$ А, $f = 5$ МГц	3*...4,9*... 20* пс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 28$ В	40*...41,8*... 70 пФ
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{кэ} = 55$ В, $R_{бэ} = 10$ Ом, не более	60 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4$ В, не более	30 мА
Разность коллекторных токов в сборке на частоте $f = 500$ МГц при $U_{п} = 28$ В, $P_{вых} = 50$ Вт, $T_k \leq +40$ °С, не более	0,5 А
КСВН при всех фазах коэффициента отражения при $U_{п} = 28$ В, $T_k \leq +50$ °С при кратковременном рассогласовании (3 с) и уровне выходной мощности на согласованной нагрузке не более 30 и 45 Вт на частотах 100 и 400 МГц, не более	10*

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания	28 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{бэ} = 10$ Ом	55 В
Постоянное напряжение база—эмиттер	4 В
Постоянный ток коллектора	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T_k \leq +40$ °С	60 Вт
Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динамическом режиме ² при $T_k \leq +80$ °С	64 Вт

¹ При $T_k > +40$ °С постоянная рассеиваемая мощность коллектора определяется из выражения

$$P_{к, макс} = (160 - T_k)/2, \text{ Вт.}$$

² При $T_k > +80$ °С

$$P_{к, ср, макс} = (160 - T_k)/1,25, \text{ Вт.}$$

Температура <i>p-n</i> перехода	+160 °С
Тепловое сопротивление переход—корпус	2 °С/Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус в динамическом режиме	1,25 °С/Вт
Температура окружающей среды	-60... T_K = = +125 °С

Принципиальная электрическая схема
транзисторной сборки 2Т9125АС

